

10 550714.035

Основные электрические параметры
при температуре 25 (±5) °C

Наименование параметра	Режим измерения	Буквенное обозначение	Значение			Единица измерения
			мин	тип	макс	
Напряжение пробоя сток-исток	$U_{ЗИ}=0В, I_{СИ}=100мкА$	$U_{СИ\ проб}$	1200	–	–	В
Ток утечки сток-исток	$U_{СИ}=1200В, U_{ЗИ}=0В$	$I_{СИ.ут}$	–	1	100	мкА
Ток утечки затвор-исток, при прямом включении	$U_{ЗИ}=25В, U_{СИ}=0В$	$I_{з.ут (пр)}$	–	1	250	нА
Ток утечки затвор-исток, при обратном включении	$U_{ЗИ}=-10В, U_{СИ}=0В$	$I_{з.ут (обр)}$	–	–	250	нА
Пороговое напряжение затвора	$U_{ЗИ}=U_{СИ}, I_{СИ}=5мА$	$U_{ЗИ\ пор}$	2,0	2,4	4,0	В
Сопротивление открытого канала сток-исток (на кристалле)	$U_{ЗИ}=20В, I_{СИ}=40А,$	$R_{СИ.отк}$	–	80	98	МОм
Общий заряд затвора	$U_n=800В, U_{ЗИ}=-5В/+20В, I_{СИ}=20А$	$Q_з$	–	80	–	нКл
Заряд затвор-исток		$Q_{ЗИ}$	–	23	–	нКл
Заряд затвор-сток		$Q_{ЗС}$	–	15	–	нКл
Время задержки при включении	$U_n=800В, U_{ЗИ}=-5/+20В, I_{СИ}=20А, R_з=2,5\ Ом$	$t_{зд.вкл}$	–	9	–	нс
Время нарастания тока стока		$t_{нр}$	–	9,5	–	нс
Время задержки выключения		$t_{зд.выкл}$	–	18	–	нс
Время спада тока стока		$t_{сп}$	–	7,5	–	нс
Входная емкость	$U_{СИ}=1000В, U_{ЗИ}=0В, f=1МГц$	C_{ies}	–	1470	–	пФ
Выходная емкость		C_{oes}	–	95	–	пФ
Обратная передаточная емкость		C_{res}	–	11	–	пФ

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инд. № докл.

Подп. и дата

Наименование параметра	Режим измерения	Буквенное обозначение	Значение			Единица измерения
			мин	тип	макс	
Напряжение на диоде в прямом включении	$I_{пр}=10A$, $U_{зи}=-5B$	$U_{пр}$	–	3,6	4,2	B
Время обратного восстановления диода	$U_{си}=800B$, $I_{пр}=25A$, $di_{пр}/dt=1000A/c$	$t_{вос.обр}$	–	35	–	нс
Пиковый ток обратного восстановления диода		$I_{вос.обр}$	–	4,5	–	A
Заряд обратного восстановления		$Q_{вос}$	–	90	–	нКл

Предельно допустимые значения электрических параметров

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Предельно-допустимая норма при эксплуатации	Единица измерения	Примечание
Напряжение сток-исток	$U_{си\ max}$	1200	B	–
Напряжение затвор-исток, предельное	$U_{зз\ max}$	–10/+25	B	–
Напряжение затвор-исток, рекомендуемое	$U_{зз}$	–5/+20	B	–
Максимально допустимый постоянный ток стока	$I_c\ max$	36	A	–
Максимальный импульсный ток стока	$I_{c,u}\ max$	80	A	–
Максимальная рассеиваемая мощность	$P_d\ max$	208	Bm	–
Рабочая температура кристалла (pn перехода)	T_{vj}	–55 до 150	°C	–
Температура хранения	T_{xp}	–55 до 150	°C	–

Тепловые характеристики

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Макс. значение	Единица измерения
Тепловое сопротивление кристалл-корпус (T0247)	$R_{\theta JC}\ (VT)$	0,6	°C/Bm

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания по применению и эксплуатации кристаллов ДП7080БС2А приведены в ТУ, СВЦ/Л.435714.035 ТУ

ВНИМАНИЕ – Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СВЦ/Л.435714.035 Д1	Лист
						3